



MSL FPGA INC 晶片參數

■ 芯片概述

MR2A08ACYS35 是来自MSL FPGA INC美时龙的 4Mb 并行 MRAM (磁阻随机存取存储器) 主要技术参数和供应信息如下：

■ 核心参数

存储类型：非易失性 MRAM (磁阻随机存取存储器)，容量 4Mbit (512K × 8位组织)
接口：并行接口 (8位数据总线) 访问速度：35ns (读/写)
工作电压：3.3V (范围 3V – 3.6V)

■ 功能特性

无限次读写：MRAM 无磨损问题，适合高频写入场景。
低功耗：工作电流 55mA (典型值)，待机电流更低。
抗干扰：磁阻技术抗辐射、抗电磁干扰，适用于严苛环境。内置低压抑制电路，防止掉电时数据损坏。

■ 应用场景

工业控制：PLC 实时数据记录、机器人运动轨迹存储。
汽车电子：ADAS 事件记录器 (EDR)、车载黑匣子。
医疗设备：高频数据采集设备 (如智能穿戴设备)。